

(12) पेटेंट आवेदन प्रकाशन

(19) भारत

(22) आवेदन फाइल करने की तिथि : 09/01/2014

(21) आवेदन सं. 190/सीएचईएनपी/2014 ए

(43) प्रकाशन की तिथि : 23/01/2015

(54) खोज का शीर्षक : ग्लास सबस्ट्रेट्स और उस पर लगे डिवाइसों पर हेटेरोएपिटेक्सियल सिंगल क्रिस्टल या लार्ज ग्रैंड सेमीकंडक्टर फिल्मों बनाने की विधि

(51) अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण :H01L21/26
(31) प्राथमिकता दस्तावेज सं :61/505795
(32) प्राथमिकता तिथि :08/07/2011
(33) प्राथमिकता देश का नाम :यू.एस.ए. (अमेरिका).
(86) अंतरराष्ट्रीय आवेदन सं :PCT/US2012/042713
फाइल करने की तिथि :15/06/2012
(87) अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सं :WO 2013/009433
(61) आवेदन सं. में जोड़ने का पेटेंट :लागू नहीं
फाइल करने की तिथि :लागू नहीं
(62) आवेदन सं. में विभाजन संबंधी :लागू नहीं
फाइल करने की तिथि :लागू नहीं

(71) आवेदक का नाम :

1) सोलर टेक्निक एलएलसी

आवेदक का पता : 416 लांग हिल रोड ईस्ट ब्रायरक्लिफ

मैनर एनवाय 10510 यू.एस.ए.

2) डार्टमाउथ कॉलेज के न्यासी

3) चौधरी अशोक

4) चौधरी करीन

5) चौधरी पिया

(72) खोजकर्ता का नाम :

1) ल्यू जिफेंग

(57) सारांश :

एक किफायती सबस्ट्रेट पर एक सिंगल क्रिस्टल या लार्ज ग्रैंड सिलिकन को जमा करके किफायती सेमीकंडक्टर तैयार किए जाते हैं। इन सेमीकंडक्टरों को इतने कम तापमान पर तैयार किया जाता है जो कांच के द्रवनांक से भी कम होता है। इस प्रकार बनाए गए सेमीकंडक्टर फोटोवोल्टाइक या डिस्प्ले जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसों के लिए उपयुक्त होते हैं।

पृष्ठों की सं.: 12 दावों की सं.: 28